



4

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Fabrice DEVAUX, et al.

Attorney Docket No. Q68526

Appln. No.: 10/074,023

Group Art Unit: 2874

Confirmation No.: 5637

Examiner: Unknown

Filed: February 14, 2002

For: MONOLITHIC INTEGRATED OPTICAL COMPONENT INCLUDING A
MODULATOR AND A HETEROJUNCTION BIPOLAR TRANSISTOR

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to
priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to
acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

David J. Cushing
Registration No. 28,703

SUGHRUE MION, PLLC
2100 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037-3213
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

Enclosures: France 0102100

Date: April 16, 2002



INPI
INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

06 8526
1041

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

18 JAN. 2002

Fait à Paris, le _____

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

BEST AVAILABLE COPY

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 250859

15 FEV 2001 Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES DATE 15 INPI PARIS LIEU N° D'ENREGISTREMENT 0102100 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 15 FEV. 2001		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet BALLOT 16 Avenue du Pont Royal 94230 CACHAN FRANCE MK/sd	
V s références pour ce dossier (facultatif) 015992 - OPT036 - FIT10384			
C nfirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Composant optique intégré monolithique comportant un modulateur et un transistor bipolaire à hétérojonction.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		ALCATEL	
Prénoms			
Forme juridique		S.A. (Société Anonyme)	
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Adresse	Rue	54, rue de la Boétie	
	Code postal et ville	75008	PARIS
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 15 FEB 2001 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0102100 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		015992 - OPT036 FIT103484 MK/sd	
6 MANDATAIRE			
Nom		BORIN	
Prénom		Lydie	
Cabinet ou Société		Cabinet BALLOT	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	16 Avenue du Pont Royal	
	Code postal et ville	94230 CACHAN	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 49 69 91 90	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 49 69 91 91	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformati n)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (<i>joindre un avis de non-imposition</i>) <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (<i>joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence</i>):	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) BORIN Lydie Mandataire n° 94-0502 Cabinet BALLOT		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M MARTIN	



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite N° .1. / .1. .

REMISE DES REQUÊTES DATE 15 FEB 2001 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0102100 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		015992 - OPT036 FIT103484 MK/sd	
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N° Pays ou organisation Date / / N°	
5 DEMANDEUR		FRANCE TELECOM	
Nom ou dénomination sociale		FRANCE TELECOM	
Prénoms			
Forme juridique		S.A. (Société Anonyme)	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	6 Place d'Alleray	
	Code postal et ville	75015	PARIS
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
5 DEMANDEUR			
Nom ou dénomination sociale			
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Pays			
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI	
BORIN Lydie Mandataire n° 94-0506 Cabinet BALLOT		M MARTIN	

015992 - OPT036 - FIT 103484
DEVAUX Fabrice, BLAYAC Sylvain, ANDRE Philippe

**COMPOSANT OPTIQUE INTEGRE MONOLITHIQUE COMPORTANT UN
MODULATEUR ET UN TRANSISTOR BIPOLAIRE A HETEROJONCTION**

L'invention concerne le domaine des composants électroniques et électro-optiques réalisés sur des matériaux à structure cristalline (matériaux III-V par exemple) et destinés à être utilisés dans le cadre
5 d'applications de transmission de données à haut débit sur fibres optiques.

L'invention concerne plus spécifiquement un composant optique monolithique intégré comportant un élément électronique et un élément électro-optique, tel
10 qu'un transistor connecté à un modulateur pour une commande en tension de ce dernier.

La présente invention cherche à améliorer les performances de l'ensemble constitué par ces deux éléments électronique et électro-optique.

15 Un modulateur électro-optique classique comporte un empilement de couches épitaxiées sur un substrat en matériau semi-conducteur III-V, généralement de l'InP. Les couches successives sont constituées d'une couche de confinement inférieure, d'une couche active, et
20 d'une couche de confinement supérieure, ces trois couches formant le guide d'onde actif du composant. En général, la couche active est composée d'un matériau quaternaire unique non dopé, par exemple du InGaAsP. Les couches de confinement sont composées d'un matériau
25 III-V, de l'InP par exemple, dopée chacune d'un type de porteurs différents et formant l'une l'anode et l'autre la cathode.

Le modulateur est généralement commandé par une source en tension, un transistor par exemple, dont l'impédance peut atteindre 50 Ohms. La fréquence de coupure résultante est alors donnée par la relation :

5
$$f_c = 1 / (2\pi(R_s + R_L)C_m).$$

Avec $R_s \approx 5\Omega$, la résistance de série du modulateur
 R_L , l'impédance de la source de commande
 C_m , la capacité du modulateur.

10 Il en résulte que le modulateur n'est pas utilisé au meilleur de ses performances et que la largeur de la bande de fréquence de fonctionnement d'un modulateur électro-optique sur InP est 5 à 10 fois inférieure à celle imposée par les limites intrinsèques au matériau. Cela est particulièrement nuisible dans le cadre
15 d'applications haut débit avec des modulateurs fonctionnant entre 40 et 160 Gb/s.

Afin de réduire l'impédance de la source de commande, il a été envisagé de réduire au maximum, voire de supprimer, les transports de charges
20 électriques entre la source et le modulateur. Cela a été tenté en rapprochant physiquement les deux éléments. Cependant, cette solution ne permet pas d'éviter totalement les parasites entre la source et le modulateur. Or, un Ohm de résistance parasite peut
25 entraîner une réduction de la bande passante en dessous de 40 GHz.

Une autre solution, proposée dans l'art antérieur, consiste à réaliser une intégration monolithique du modulateur avec le transistor de commande en intégrant

la couche active du modulateur dans la structure du transistor (dans la couche de collecteur).

Une telle solution comporte cependant des inconvénients. La couche active du modulateur est
5 située dans la zone de déplétion du collecteur, ce qui, en schéma équivalent, consiste à placer le modulateur en série du collecteur. Comme il n'y a alors plus accès à une des couches du modulateur, la commande est
10 réalisée en courant et non plus en tension. Une telle commande en courant implique une forte résistance de charge, qui peut même être supérieure à 50Ω . La largeur de la bande passante du modulateur n'est donc pas améliorée.

15 Le but de la présente invention est de proposer une intégration du composant électro-optique avec l'élément électrique de commande de manière à minimiser les résistances parasites et à permettre le fonctionnement optimal dudit composant électro-optique.

20 A cet effet, l'invention propose d'utiliser un transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) comme source de commande en tension et de réaliser une intégration monolithique du composant électro-optique audit transistor HBT.

25 Selon la présente invention, l'intégration du composant électro-optique se situe dans la couche de sous-collecteur du transistor HBT qui constitue avantageusement une des couche de confinement dudit composant.

A cet effet, la structure active du composant électro-optique doit être élargie pour que la couche de sous-collecteur constitue directement la couche supérieure de confinement dudit composant. La taille du transistor ne pouvant pas être réduite en deçà d'une
5 valeur limite imposée par les contraintes de fabrication et de conception, c'est la largeur du composant électro-optique qui doit être augmentée.

Cependant, un élargissement du guide d'onde actif
10 du composant électro-optique entraîne la perte de la propagation monomode du signal dans ledit composant. L'invention propose par conséquent d'allonger la zone élargie du guide d'onde actif du composant, zone située sous le transistor HBT, afin de transformer cette zone
15 élargie en un coupleur à interférence multimode comportant un guide d'onde d'entrée et un guide d'onde de sortie monomodes.

L'invention a plus particulièrement pour objet un composant optique intégré monolithique comprenant un
20 transistor de commande connecté à un composant électro-optique comportant un guide d'onde actif et au moins un guide d'onde d'entrée et un guide d'onde de sortie, caractérisé en ce que ledit transistor est un transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) comportant
25 au moins une couche de sous-collecteur qui est commune à une couche de confinement du composant électro-optique, et en ce que le guide d'onde actif dudit composant électro-optique comporte une structure élargie située sous une zone de contact du transistor
30 (HBT) et présentant sensiblement la même surface que ledit transistor.

Selon une caractéristique, la structure élargie du guide d'onde actif est allongée de manière à constituer un coupleur à interférence multimode (MMIC).

Les particularités et avantages de l'invention
5 apparaîtront clairement à la lecture de la description qui suit, faite à titre d'exemple illustratif et non limitatif et en regard aux figures annexées sur lesquels :

la figure 1 illustre schématiquement l'empilement
10 de couches épitaxiées du composant optique intégré monolithique selon l'invention.

la figure 2 est une vue schématique de dessus du composant selon l'invention.

15 La présente invention cherche à réduire l'impédance de la source de commande d'un composant électro-optique. A cet effet, l'invention propose d'intégrer ledit composant électro-optique à ladite source de commande constituée par un transistor bipolaire à
20 hétérojonction (HBT). Cette intégration est bien illustrée sur le schéma de la figure 1.

Les transistors bipolaires à hétérojonction 10 (HBT) sont parfaitement bien maîtrisé dans l'état de la technique. Ils sont généralement constitués de
25 plusieurs couches épitaxiées sur un substrat 100 en matériau semi-conducteur III-V, classiquement de l'InP. Les différentes couches épitaxiées sont gravées pour constituer des mesas qui définissent le collecteur C, la base B et l'émetteur E du transistor 10. Des
30 contacts électriques 11,12,13 doivent être pris sur

chacun des mesas par un dépôt de zones métallique (appelées également zones de contact).

Généralement l'hétérojonction se situe entre la base B et l'émetteur E, les couches correspondantes
5 étant réalisées dans des matériaux semi-conducteurs différents. Par exemple, une couche de base B en InGaAs et une couche d'émetteur E en InP dopée chacune d'un type différent. L'hétérojonction autorise des dopages de la base très élevés et permet la réalisation d'une
10 base très fine. On obtient ainsi des fréquences de fonctionnement très élevées.

Selon les applications, un transistor bipolaire peut être à simple ou à double hétérojonction, la seconde hétérojonction se situant entre la base et le
15 collecteur selon le même principe d'agencement de couche épitaxiées.

Eventuellement, la couche de collecteur C peut être déposée sur une couche intermédiaire de sous-collecteur SC et non directement sur le substrat 100. Le sous-
20 collecteur SC est constitué d'un matériau semi-conducteur différent de celui du collecteur mais dopé du même type. Le contact métallique 13 du collecteur C est alors pris sur la couche de sous-collecteur SC.

Selon une caractéristique essentielle de
25 l'invention, le composant électro-optique 20 est placé en dessous du transistor 10 de commande, la couche de sous-collecteur SC dudit transistor 10 étant utilisée pour constituer la couche supérieure de confinement 21 dudit composant 20.

30 Dans l'exemple de la figure 1, le composant électro-optique 20 est un modulateur dont le guide

d'onde actif 25 est constitué d'une couche de confinement supérieure 21, d'une couche active 22 et d'une couche de confinement inférieure 23 déposées sur le substrat 100.

5 Selon d'autres applications de l'invention, le composant électro-optique peut être, par exemple, une source laser, une photodiode, un amplificateur optique en semi-conducteur ou autre.

10 Afin de permettre la mise en œuvre de l'invention, le guide d'onde actif 25 du composant électro-optique 20 doit être élargi pour que la couche de sous-collecteur SC du transistor HBT 10 constitue directement la couche de confinement supérieure 21 dudit composant 20.

15 En effet, classiquement, la largeur d'un guide d'onde actif est largement plus petite que celle d'un transistor (environ dix fois plus petite). Or, la taille du transistor HBT 10 ne peut pas être réduite en deçà d'une valeur limite. C'est donc la largeur du
20 composant électro-optique 20 qui doit être augmentée.

25 Ainsi, le guide d'onde actif 25 du composant électro-optique 20 comporte une structure élargie 30 située sous la zone de contact 13 du transistor HBT 10 et présentant sensiblement la même surface que la
couche de sous collecteur SC dudit transistor 10.

30 Cependant, un élargissement du guide d'onde actif 25 entraîne la perte de la propagation monomode du signal dans le composant électro-optique 20. L'invention propose alors d'allonger la structure élargie 30 du composant électro-optique 20 afin de la transformer en un coupleur à interférence multimode

(MMIC) comportant au moins un guide d'onde d'entrée 26 et un guide d'onde de sortie 27 monomodes (MMIC 1x1). Un tel allongement de la structure élargie 30 du composant électro-optique 20 implique nécessairement un
 5 allongement de la couche de sous-collecteur SC du transistor 10, mais cela ne nuit aucunement au bon fonctionnement dudit transistor HBT.

En se référant à la figure 2, la longueur L_{MMI} de la structure élargie 30 du composant électro-optique 20
 10 est reliée directement à sa largeur W_{MMI} selon la relation suivante :

$$L_{MMI} = n W_{MMI}^2 / \lambda$$

Avec n l'indice effectif du guide d'onde 25, et λ la longueur d'onde du signal optique se propageant dans
 15 le composant électro-optique 20.

Sans sortir du cadre de l'invention, on peut envisager d'appliquer l'intégration du composant électro-optique avec un transistor HBT dans un cas où
 20 ledit composant aurait N guides d'onde d'entrée et N guides d'onde de sortie monomodes.

La réalisation de l'invention fait appel à des procédés de fabrication connus et bien maîtrisés dans l'état de la technique.

25 Le composant électro-optique 20 et le transistor bipolaire à hétérojonction 10 sont intégrés sur un substrat 100, en InP semi-isolant par exemple. L'intégration est réalisée par un empilement de couches successives déposées par épitaxie selon des procédés
 30 bien connus permettant un bon contrôle des épaisseurs

et des compositions de chaque couche épitaxiée. Cet empilement de couches successives est bien explicité par la figure 1.

5 L'invention permet avantageusement de réduire la résistance série entre le composant électro-optique 20 et le transistor de commande 10 en éliminant les résistances parasites liées aux contacts métalliques entre les deux éléments. En pratique, une résistance
10 série de 3Ω a pu être obtenue. Avec une résistance série aussi faible, le modulateur 20 peut être commandé par une source d'impédance de 10Ω . La largeur de la bande passante peut ainsi être augmentée d'un facteur 2 à 3 par rapport à la largeur actuelle, tous les autres
15 paramètres étant maintenus identiques. Les limites intrinsèques du composant peuvent donc être approchées davantage.

L'intégration du composant électro-optique au transistor de commande entraîne une dissipation
20 thermique qui peut nuire aux performances dudit composant. En outre, un coupleur MMI induit environ 1dB de pertes optiques. Ces inconvénients sont cependant négligeables en regard des améliorations apportées par la présente invention.

REVENDICATIONS

1. Composant optique intégré monolithique comprenant un transistor de commande (10) connecté à un composant électro-optique (20) comportant un guide d'onde actif (25) et au moins un guide d'onde d'entrée (26) et un guide d'onde de sortie (27), caractérisé en ce que ledit transistor (10) est un transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) comportant au moins une couche de sous-collecteur (SC) qui est commune à une couche de confinement (21) du composant électro-optique (20), et en ce que le guide d'onde actif (25) dudit composant électro-optique (20) comporte une structure élargie (30) située sous une zone de contact du transistor bipolaire à hétérojonction (10) et présentant sensiblement la même surface que ledit transistor (10).

2. Composant optique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la structure élargie (30) du guide d'onde actif (25) est allongée de manière à constituer un coupleur à interférence multimode (MMIC).

3. Composant optique selon la revendications 2, caractérisé en ce que le coupleur à interférence multimode (MMIC) est un coupleur à un guide d'onde d'entrée et un guide d'onde de sortie (MMIC 1x1).

4. Composant optique selon la revendications 2, caractérisé en ce que le coupleur à interférence multimode (MMIC) est un coupleur à N guides d'onde d'entrée et N guides d'onde de sortie (MMIC NxN).

5

5. Composant optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le composant électro-optique est un modulateur.

10

6. Composant optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le composant électro-optique est une source laser.

15

7. Composant optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le composant électro-optique est une photodiode.

20

8. Composant optique selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le composant électro-optique est un amplificateur optique en semi-conducteur.

Fig 1

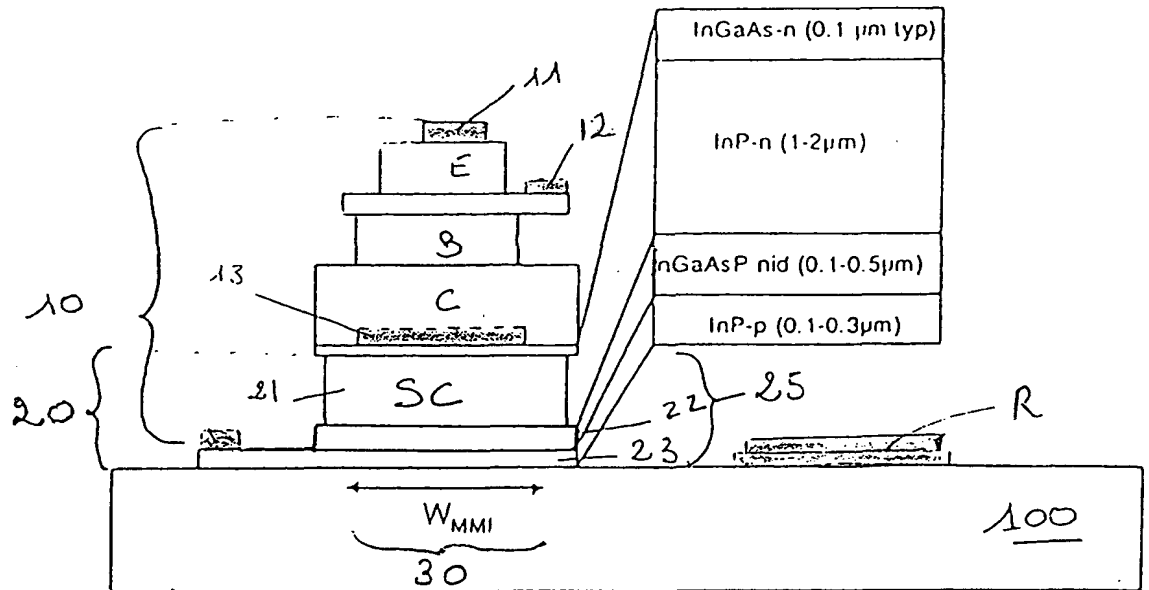
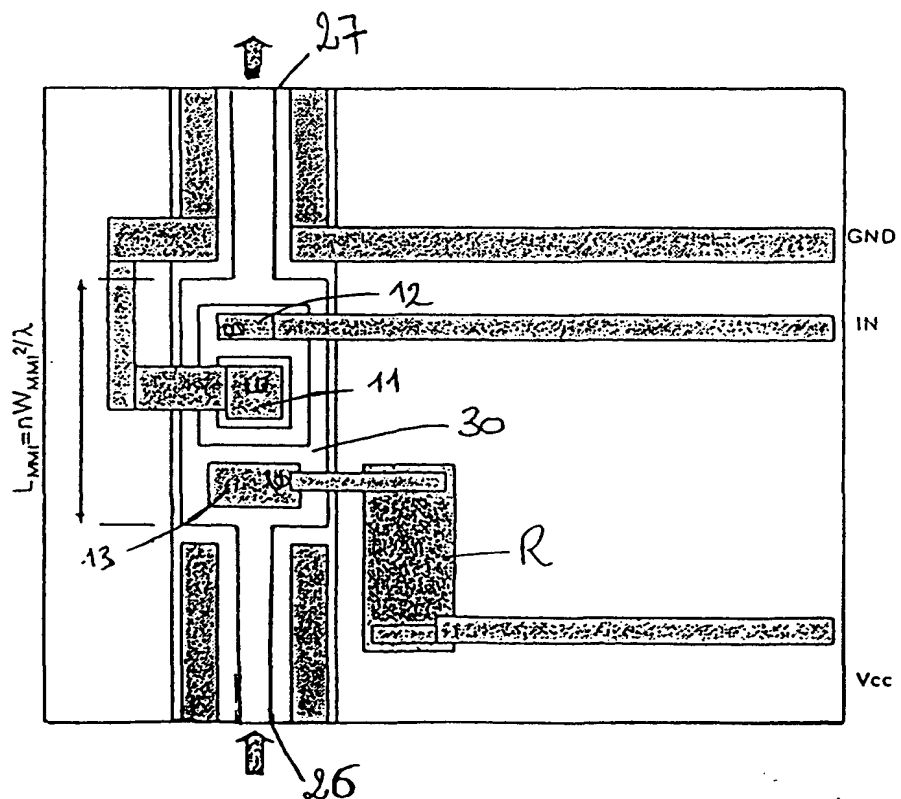


Fig 2



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ..1/..1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 250899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		015992 - OPT036 - FIT103484	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0102100	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Composant optique intégré monolithique comportant un modulateur et un transistor à hétérojonction.			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
ALCATEL (S. A.) 54 Rue de la Boétie 75008 PARIS France		FRANCE TELECOM (S. A.) 6 Place d'Alleray 75015 PARIS France	
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		DEVAUX	
Prénoms		Fabrice	
Adresse	Rue	Domicilié au Cabinet BALLOT 16 Avenue du Pont Royal	
	Code postal et ville	94230	CACHAN
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BLAYAC	
Prénoms		Sylvain	
Adresse	Rue	Domicilié au Cabinet BALLOT 16 Avenue du Pont Royal	
	Code postal et ville	94230	CACHAN
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		ANDRE	
Prénoms		Philippe	
Adresse	Rue	DOMICILIE AU CABINET BALLOT 16 Avenue du Pont Royal	
	Code postal et ville	94230	CACHAN
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
BORIN Lydie Mandataire n° 94-0506 Cabinet BALLOT			

